

請求の範囲

- [請求項1] 回路形成面を有する電子部品と、基材層および粘着性樹脂層を有するとともに、前記回路形成面を保護するように前記電子部品の前記回路形成面に前記粘着性樹脂層側が貼り付けられた粘着性積層フィルムと、を備える構造体を準備する工程（A）と、
- 前記粘着性積層フィルムに貼り付けられた状態で、前記電子部品の前記回路形成面とは反対側の面をバックグラインドする工程（B）と、
- 前記粘着性積層フィルムに貼り付けられた状態で、前記電子部品をダイシングする工程（C）と、
- 前記粘着性積層フィルムに貼り付けられた状態で、個片化された前記電子部品に対して電磁波シールド層を形成する工程（D）と、
- をこの順番に含み、
- 前記工程（A）、前記工程（B）、前記工程（C）および前記工程（D）において、前記粘着性積層フィルムとして同一の粘着性積層フィルムを使用する電子装置の製造方法。
- [請求項2] 請求項1に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記粘着性積層フィルムは、前記基材層と前記粘着性樹脂層との間に凹凸吸収性樹脂層をさらに有する電子装置の製造方法。
- [請求項3] 請求項2に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記工程（A）と前記工程（D）との間に、前記凹凸吸収性樹脂層を架橋させることで、前記凹凸吸収性樹脂層の耐熱性を向上させる工程（E）をさらに含む電子装置の製造方法。
- [請求項4] 請求項2または3に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記凹凸吸収性樹脂層が架橋性樹脂を含む電子装置の製造方法。
- [請求項5] 請求項2乃至4のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記凹凸吸収性樹脂層の厚みが10 μm 以上1000 μm 以下であ

る電子装置の製造方法。

[請求項6] 請求項 1 乃至 5 のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、

前記工程（D）の後に前記電子部品と前記粘着性積層フィルムとを剥離する工程（F）をさらに含む電子装置の製造方法。

[請求項7] 請求項 6 に記載の電子装置の製造方法において、

前記工程（F）では、前記粘着性積層フィルムにおける前記電子部品が貼り付けられた領域をフィルムの面内方向に拡張させて、隣接する前記電子部品間の間隔を拡大させた状態で、前記粘着性積層フィルムから前記電子部品を剥離する電子装置の製造方法。

[請求項8] 請求項 6 または 7 に記載の電子装置の製造方法において、

前記粘着性樹脂層は放射線架橋型粘着剤を含み、

前記工程（F）の前に、前記粘着性樹脂層に対して放射線を照射して前記粘着性樹脂層を架橋させる工程（G）をさらに含む電子装置の製造方法。

[請求項9] 請求項 1 乃至 8 のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、

前記電子部品の前記回路形成面はバンプ電極を含む電子装置の製造方法。

[請求項10] 請求項 9 に記載の電子装置の製造方法において、

前記バンプ電極の高さを H [μm] とし、前記凹凸吸収性樹脂層の厚みを d [μm] としたとき、 H/d が 0.01 以上 1 以下である電子装置の製造方法。

[請求項11] 請求項 1 乃至 10 のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、

前記工程（D）では、スパッタリング法、蒸着法、スプレーコーティング法、電解メッキ法および無電解メッキ法から選択される少なくとも一種の方法を用いて前記電子部品に対して前記電磁波シールド層

を形成する電子装置の製造方法。

[請求項12] 請求項 1 乃至 11 のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、

前記工程（D）では、少なくとも前記電子部品における前記回路形成面に対向する対向面および前記回路形成面と前記対向面とを繋ぐ側面に対して前記電磁波シールド層を形成する電子装置の製造方法。

[請求項13] 請求項 1 乃至 12 のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、

前記基材層を構成する樹脂がポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリイミド系エラストマー、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、およびポリイミドからなる群から選択される一種または二種以上を含む電子装置の製造方法。

[請求項14] 請求項 1 乃至 13 のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、

前記粘着性樹脂層を構成する粘着剤が（メタ）アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ウレタン系粘着剤、オレフィン系粘着剤およびスチレン系粘着剤から選択される一種または二種以上を含む電子装置の製造方法。